

明 細 書

処理装置及び処理方法

技術分野

本発明は、被処理体表面に形成された酸化膜を除去する処理装置及び処理方法に関する。

背景技術

従来、ウェハ形成された微細なホール内の自然酸化膜を有効に除去する方法としては、例えば、以下のような表面処理方法がある。

まず、 N_2 ガスと H_2 ガスの混合ガスをプラズマにより活性化して活性ガス種を形成し、この活性ガス種のダウンフローに NF_3 ガスを添加して NF_3 ガスを活性化する。この NF_3 ガスの活性ガス種をウェハの表面の自然酸化膜と反応させて生成膜を形成し、その後ウェハを所定の温度に加熱することにより前記生成膜を昇華させて除去する。

このような方法に使用される装置としては、内部にウェハを収納する処理容器と、 NF_3 ガスの活性ガス種を生成する NF_3 活性ガス種生成装置と、ウェハを加熱するために処理容器の外部に設けられた加熱手段と、この加熱手段と前記被処理体との間に設けられ、加熱手段からの熱エネルギーを透過する透過窓とを備えた処理装置が知られている。そして、ウェハの表面に形成された自然酸化膜に、 NF_3 ガスの活性ガス種を低温で反応させて生成膜を形成し、この生成膜を加熱手段によって所定の温度に加熱して昇華させ、前記自然酸化膜を除去するようになっている。

しかしながら、上記処理装置にあっては、被処理ウェハの加熱処理後に、新たな被処理ウェハを処理容器に導入して低温処理を行おうとすると、前回の加熱処理時の熱が透過窓に蓄積されており、この透過窓からの熱放射によってウェハが加熱されてしまう。このため、透過窓が所定の温度まで冷却されるのを待たねばならず、処理能率が著しく低下するという問題点があった。

請求の範囲第1項に記載の発明は、被処理体の表面に形成された酸化膜を除去するための処理装置であって、被処理体を収納する処理容器と、活性ガス種を生成する活性ガス種生成装置と、処理容器の外部に設けられ被処理体を加熱する加熱手段と、この加熱手段と被処理体との間の処理容器に設けられた透過窓であって、処理容器の内外を気密に遮蔽するとともに加熱手段からの加熱用のエネルギーを透過する透過窓と、被処理体と透過窓との間に挿抜可能に設けられた遮蔽板とを備え、遮蔽板を閉状態にして透過窓からの放射熱を遮断した状態で、被処理体の表面に形成された酸化膜に、活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成し、その後、遮蔽板を開状態にして、加熱手段からの放射熱を透過窓を通して生成膜に加え、所定の温度に加熱して気化させ、生成膜を除去することを特徴とする。

請求の範囲第 3 項に記載の発明は、活性ガス種は、N F 3 ガスの活性ガス種であることを特徴とする。

請求の範囲第４項に記載の発明は、遮蔽板には、この遮蔽板を冷却する冷却手段が設けられていることを特徴とする。

請求の範囲第5項に記載の発明は、搬送手段は、第1の処理室と第2の処理室に接続されるとともに内部が非反応性雰囲気になされた搬送室内に設けられてい

ることを特徴とする。

請求の範囲第6項に記載の発明は、活性ガス種生成装置は、プラズマ形成部を有するプラズマ形成管と、このプラズマ形成管内にN₂ガスとH₂ガスを供給するプラズマガス導入部と、プラズマ形成管内からダウンフローする活性ガス種にNF₃ガスを添加するNF₃ガス供給部とを備えていることを特徴とする。

請求の範囲第7項に記載の発明は、プラズマ形成部は、マイクロ波を発生するマイクロ波発生源と、発生したマイクロ波をプラズマ形成管内へ導入する導波管とよりなることを特徴とする。

請求の範囲第8項に記載の発明は、被処理体を収納する処理容器と、この処理容器の外部に設けられ被処理体を加熱する加熱手段と、この加熱手段と被処理体との間の処理容器に設けられた透過窓と、被処理体と透過窓との間に挿抜可能に設けられた遮蔽板とを有する処理装置を用いて、被処理体の表面に形成された酸化膜を除去するための処理方法であって、遮蔽板を閉状態にして透過窓からの放射熱を遮断した状態で、被処理体の表面に形成された酸化膜に、活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成し、その後、遮蔽板を開状態にして、加熱手段からの放射熱を透過窓を通して生成膜に加え、所定の温度に加熱して気化させ、生成膜を除去することを特徴とする。

請求の範囲第9項に記載の発明は、被処理体の表面に形成された酸化膜を除去する処理方法であって、第1の処理室において、被処理体の表面に形成された酸化膜に活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成する工程と、生成膜が形成された被処理体を前記第1の処理室から第2の処理室へ搬送する工程と、第2の処理室において、被処理体の表面に形成された生成膜を所定の温度に加熱して気化させ、生成膜を除去する工程とを有することを特徴とする。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1の実施の形態の処理装置を示す構成図である。

図2は、図1に示す処理装置の可動シャッタを示すII-II線に沿う概略平面図である。

図3は、図2中III-III線に沿う概略断面図である。

発明を実施するための最良の形態

一方、プラズマ形成管 14 は、例えば石英により管状に成形されており、上記処理容器 16 の天井部に開口するとともに、この処理容器 16 に起立させた状態で気密に取り付けられている。このプラズマ形成管 14 の上端には、この管内に N2 ガスと H2 ガスよりなるプラズマガスを導入するプラズマガス導入部 44 が設けられる。このプラズマ導入部 44 は、プラズマ形成管 14 内に挿通された導入ノズル 46 を有しており、この導入ノズル 46 にはガス通路 48 が連結されている。このガス通路 48 には、それぞれマスフローコントローラのごとき流量制御器 50 を介して N2 ガスを充填した N2 ガス源 52 及び H2 ガスを充填し

そして、駆動モータ１１５を作動させることによって、軸側ギア１１１とモータ側ギア１１３を介して遮蔽板１０３を回動させ、図２に示すような開位置と図３に示すような閉位置に位置せしめることができるようになっている。

一方、図4は、他の可動シャッタ121の例を示す図である。この可動シャッタ121は、透過窓28をおおう遮蔽板123を有している。この遮蔽板123には、2つの駆動軸125、125が接続されており、この駆動軸125、125の他端には、油圧シリンダ127のピストンロッドが連結されている。また、駆動軸125が処理容器16の外壁を129を貫通する部分には、この駆動軸125と外壁129との間に磁性流体シール131が設けられており、駆動軸125と外壁129との間を気密に維持しつつ駆動軸を外壁に対して移動できるようになっている。そして、油圧シリンダ127を作動させることによって、遮蔽板123を、開位置と閉位置に位置せしめることができるようになっている。

この場合においても、図３に示す場合と同様に、遮蔽板１２３および駆動軸１２５の内部に冷媒通路を形成し、処理容器１６の外部に位置する冷媒通路の端部に、処理容器１６の外部に設けた冷媒循環手段を接続して、遮蔽板１２３を冷却可能に構成することもできる。このようすれば、遮蔽板１２３からの輻射熱によるウエハＷの温度上昇を抑制することができる。

次に、以上のように構成された装置を用いて行なわれる自然酸化膜の除去方法について説明する。まず、被処理体である半導体ウエハWを、図示しないゲートバルブを介して処理容器16内に導入し、これを載置台20上に載置する。このウエハWには、例えば前段階でコンタクトホール等が形成されており、その底部の表面に自然酸化膜が発生している。

ウェハWを処理容器16内に搬入したならば、処理容器16内を密閉し、内部を真空引きする。そして、N₂ガス源52及びH₂ガス源54よりN₂ガス及

一方、NF₃ガス供給部68のリング状のシャワーヘッド70からは、NF₃ガス源80より供給されたNF₃ガスがN₂ガスとH₂ガスよりなる混合ガスのダウンプローの活性ガス種に添加される。この結果、添加されたNF₃ガスもダウンプローの活性ガス種により活性化されることになる。このようにNF₃ガスも活性ガス化され、上記したダウンプローの活性ガス種と相まってウェハWの表面の自然酸化膜と反応し、Si、N、H、Fの混合した生成膜を形成することになる。

ここで、この処理中は、可動シャッタ 103 は閉状態になされている。これは、前回の加熱処理中に加熱された透過窓 28 からの輻射熱がウェハ W に到達し、ウェハの温度が上昇するのを防止するためである。

このように生成膜の形成が完了したならば、H₂、NF₃、N₂のそれぞれのガスの供給を停止すると共に、マイクロ波発生源58の駆動も停止し、処理容器16内を真空引きして残留ガスを排除する。その後、可動シャッタ103を開状

一方、前記搬送室203のロードロック室205と反対の側には、2つの低温処理室207、207がそれぞれ設けられている。この低温処理室207は、図

また、搬送室 203 には、加熱室 209 が設けられている。この加熱室 209 の内部には、加熱手段、例えば公知の抵抗加熱式ステージヒータが設けられ、このステージヒータによりウエハ W を加熱することができる。この加熱室 209 では、低温処理後のウエハ W を所定の温度、例えば 100℃ 以上に加熱し、この加熱により上記生成膜は昇華（気化）する。これにより、ウエハ W の自然酸化膜が除去される。

さらに、搬送室 203 には、冷却室 211 が設けられている。この冷却室 211 は、加熱処理後のウェハを冷却するためのものである。処理後のウェハは、樹脂製のカセットに収納されて搬出されることになっているが、ウェハが高温のままだと樹脂製カセットを痛めるおそれがある。このため、カセットへ収納する前にウェハを冷却するようにしている。

このような処理装置 201 において、自然酸化膜が表面に形成された被処理ウェハは、ロードロック室 205 から搬送室 203 へ搬入される。ついで、このウェハは、低温処理室 207 に搬送され、ここにおいていわゆる低温処理を施される。ここで、この処理装置 201 にあっては、低温処理室 207 に対して加熱室 209 は別に設けられているから、前回の加熱処理中の熱が残存して低温処理に悪影響を及ぼすのを防止することができる。その後、被処理ウェハは加熱室 209 に送られる。ここで、低温処理後のウェハ W を所定の温度、例えば 100℃ 以上に加熱し、この加熱により上記生成膜は昇華（気化）する。これにより、ウェハ W の自然酸化膜が除去される。その後、この加熱されたウェハは、冷却室 211 に送られる。ウェハは、ここで冷却されてから、カセットに収納されて搬出される。従って、高温のままのウェハが樹脂製カセットを痛めるおそれを防止する

本発明にあっては、被処理体と透過窓との間に挿抜可能に遮蔽板を設けている。従って、遮蔽板を閉状態にして透過窓からの放射熱を遮断し、低温状態で酸化膜に活性ガス種を反応させることができる。また、本発明にあっては、酸化膜に活性ガス種を反応させる低温処理とその後の加熱処理とを別の室で行っている。従って、低温処理と加熱処理とを連続して行うことができ、酸化膜除去作業を効率的に行うことができる。

この加熱手段と前記被処理体との間の前記処理容器に設けられた透過窓であつて、前記処理容器の内外を気密に遮蔽するとともに前記加熱手段からの加熱用のエネルギーを透過する透過窓と、

前記遮蔽板を閉状態にして前記透過窓からの放射熱を遮断した状態で、被処理体の表面に形成された酸化膜に、前記活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成し、

その後、前記遮蔽板を開状態にして、前記加熱手段からの放射熱を前記透過窓を通して前記生成膜に加え、所定の温度に加熱して気化させ、前記生成膜を除去する処理装置。

2. 被処理体の表面に形成された酸化膜を除去するための処理装置であって、
 活性ガス種を生成する活性ガス種生成装置を有し、被処理体の表面に形成され
 た酸化膜に、前記活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成する第1の処
 理室と、

前記被処理体を加熱する加熱手段を有し、この加熱手段で前記被処理体の表面に形成された生成膜を所定の温度に加熱して気化させ、前記生成膜を除去する第2の処理室と、

これら第 1 の処理室と第 2 の処理室との間で前記被処理体を搬送する搬送手段と、
を備えた処理装置。

3. 前記活性ガス種は、NF₃ガスの活性ガス種である請求の範囲第1項又

は第 2 項のいずれかに記載の処理装置。

4. 前記遮蔽板には、この遮蔽板を冷却する冷却手段が設けられている請求の範囲第 1 項に記載の処理装置。

5. 前記搬送手段は、前記第 1 の処理室と前記第 2 の処理室に接続されるとともに内部が非反応性雰囲気になされた搬送室内に設けられている請求の範囲第 2 項に記載の処理装置。

6. 前記活性ガス種生成装置は、プラズマ形成部を有するプラズマ形成管と、このプラズマ形成管内に N₂ ガスと H₂ ガスを供給するプラズマガス導入部と、前記プラズマ形成管内からダウンフローする活性ガス種に NF₃ ガスを添加する NF₃ ガス供給部とを備えている請求の範囲第 1 項又は第 2 項に記載の処理装置。

7. 前記プラズマ形成部は、マイクロ波を発生するマイクロ波発生源と、発生したマイクロ波を前記プラズマ形成管内へ導入する導波管とよりなる請求の範囲第 6 項に記載の処理装置。

8. 被処理体を収納する処理容器と、この処理容器の外部に設けられ前記被処理体を加熱する加熱手段と、この加熱手段と前記被処理体との間の前記処理容器に設けられた透過窓と、前記被処理体と前記透過窓との間に挿抜可能に設けられた遮蔽板とを有する処理装置を用いて、被処理体の表面に形成された酸化膜を除去するための処理方法であって、

前記遮蔽板を閉状態にして前記透過窓からの放射熱を遮断した状態で、前記被処理体の表面に形成された酸化膜に、活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成し、

その後、前記遮蔽板を開状態にして、前記加熱手段からの放射熱を前記透過窓を通して前記生成膜に加え、所定の温度に加熱して気化させ、前記生成膜を除去

する処理方法。

9. 被処理体の表面に形成された酸化膜を除去する処理方法であって、
第1の処理室において、被処理体の表面に形成された酸化膜に活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成する工程と、

前記生成膜が形成された被処理体を前記第1の処理室から第2の処理室へ搬送する工程と、

前記第2の処理室において、前記被処理体の表面に形成された前記生成膜を所定の温度に加熱して気化させ、前記生成膜を除去する工程と、
を具備する処理方法。

0055750-002000

要 約 書

活性ガス種を被処理体の酸化膜に反応させて生成膜を形成する低温工程と、被処理体を所定の温度に加熱することにより生成膜を気化させる加熱工程とを交互に連続して行うことができる処理装置及び処理方法を提供する。この処理装置 12 は、被処理体 W と透過窓 28 との間に挿抜可能な遮蔽板 103 を設け、遮蔽板 103 を閉状態にして透過窓 28 からの放射熱を遮断した状態で、被処理体の表面に形成された自然酸化膜に、NF₃ ガスの活性ガス種を低温状態で反応させて生成膜を形成し、その後、遮蔽板 103 を開状態にして、加熱ランプ 36 からの放射熱を透過窓 28 を通して生成膜に加え、自然酸化膜を除去するようにしている。また、低温で自然酸化膜に NF₃ を反応させる低温処理室 207 と生成膜を加熱する加熱室 209 とを別々に有している。